

Реєстраційна картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0124U003608

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 29-07-2024



II. Підстава для проведення робіт

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напря́м фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки ()

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201380

У тому числі по роках:	
2024	199.000 тис. грн.
2025	199.000 тис. грн.
Загальний обсяг фінансування: 398.000 тис. грн.	

III. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 38621185

Місцезнаходження: проспект Берестейський, буд. 10, м. Київ, 01135, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 3804444813221

IV. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: проспект Науки, буд. 41, м. Київ, 03028, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380445254020, 380445258342

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розвиток і характеристика МДН польових транзисторів на базі двовимірних MoS₂ шарів

Назва роботи англійською:

Development and characterization of 2D MoS₂ based MOSFET devices

Мета роботи українською:

Виготовлення польового транзистора на базі двовимірної (2D) плівки MoS₂ з якісними межами поділу між 2D напівпровідниковою плівкою та діелектричними шарами і мінімальним зарядом в затворному діелектрику.

Мета роботи англійською:

Fabrication of 2D MoS₂ based MOSFET with high-quality interfaces between 2D semiconductor film and dielectric layers and with a minimum charge in the gate dielectric

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Нові речовини і матеріали

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Вироби технічні

Галузь застосування: Мікро- та наноелектроніка

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Назаров Олексій Миколайович

Науковий ступінь: д.ф.-м.н.

Вчене звання: професор

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Дослідження впливу ВЧ плазми на фізичні властивості тонких шарів MoS₂ та вивчення електричних параметрів вихідних структур MoS₂/діелектрик

Початок етапу: 05.2024

Закінчення етапу: 12.2024

Вид звітнього документа: Проміжний звіт

Номер етапу: 2

Назва етапу: Дослідження параметрів тестових МДНПТ приладів. Вивчення ефекту ВЧ плазми на тестові МДН ПТ прилади

Початок етапу: 01.2025

Закінчення етапу: 12.2025

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

Індекс УДК: 621.373.8+621.375.8, 621.315.592

Коди тематичних рубрик: 47.33.37, 47.09.29

IX. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Мельник Віктор Павлович

д. ф.-м. н.

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Гоменюк Юрій Вікторович

Телефон

+38 (050) 213-32-14

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Т.А.